

表面化学分析－全反射蛍光 X 線分析法
(TXRF) によるシリコンウェーハ
表面汚染元素の定量方法

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	附属書 B B.1	$(\mu/\rho)_{M,\lambda_p}$: 試料 M に入射する X 線の質量吸収係数 [2] γ_A : 元素 A の当該殻の吸収端におけるジャンプ比 [2] ω_A : 元素 A の当該殻の蛍光収率 [2, 3, 4] g_L : 測定されたスペクトル L の相対遷移確率 [5]	$(\mu/\rho)_{M,\lambda_p}$: 試料 M に入射する X 線の質量吸収係数 [1] γ_A : 元素 A の当該殻の吸収端におけるジャンプ比 [1] ω_A : 元素 A の当該殻の蛍光収率 [1, 2, 3] g_L : 測定されたスペクトル L の相対遷移確率 [4]
	附属書 E E.2	フィルム状汚染のアングルスキャン [6,15]	フィルム状汚染のアングルスキャン [5,14]
	E.3	粒子状汚染のアングルスキャン [12]	粒子状汚染のアングルスキャン [11]

平成 17 年 10 月 3 日作成